

平成 29 年度弁理士試験論文式筆記試験問題

[電磁気学]

- 1 真空の 3 次元 xyz 空間中で、厚みが無視できる無限に広がった導体板 1 が平面 $z=0$ の位置に置かれている。導体板 1 には電荷が面電荷密度 σ_0 ($\sigma_0 > 0$) で均一に分布している。 $z=0$ において、電位 $V=0$ とする。真空の誘電率を ϵ_0 とする。

【45点】

- (1) 点 (x, y, z) における電場 $\mathbf{E} = (E_x, E_y, E_z)$ の z 成分 E_z と電位 V を求めよ。また E_z と V の概形を z の関数としてグラフに描け。

さらに、厚みが無視できる無限に広がった導体板 2 を平面 $z=d$ ($d > 0$) の位置に置く。導体板 2 には電荷が面電荷密度 $-\sigma_0$ で均一に分布している。

- (2) 点 (x, y, z) における電場 $\mathbf{E} = (E_x, E_y, E_z)$ の z 成分 E_z と電位 V を求めよ。また E_z と V の概形を z の関数としてグラフに描け。

- (3) 導体板 1 と導体板 2 をコンデンサーとして利用する場合の単位面積あたりの静電容量 C を求めよ。

さらに、厚みが無視できる無限に広がった導体板 3 を平面 $z=-d$ の位置に置く。導体板 3 には電荷が面電荷密度 $2\sigma_0$ で均一に分布している。

- (4) 点 (x, y, z) における電場 $\mathbf{E} = (E_x, E_y, E_z)$ の z 成分 E_z と電位 V を求めよ。また E_z と V の概形を z の関数としてグラフに描け。

さらに、導体板 1 と導体板 2 の間に誘電率 $4\epsilon_0$ の誘電体を充填し、導体板 1 と導体板 3 の間に誘電率 $2\epsilon_0$ の誘電体を充填した。

- (5) 点 (x, y, z) における電場 $\mathbf{E} = (E_x, E_y, E_z)$ の z 成分 E_z と電位 V を求めよ。また E_z と V の概形を z の関数としてグラフに描け。

2 真空の3次元 xyz 空間中で、向かい合う辺の長さがそれぞれ $2a$ 及び $2b$ の長方形のコイルに電流 I が流れている。コイルの頂点の位置は $A(a,b,0)$, $B(-a,b,0)$, $C(-a,-b,0)$, $D(a,-b,0)$ であり、 $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A$ の向きに電流が流れている。コイルの導線の太さは無視できるものとする。微小電流 $I d\mathbf{s}$ (電流の大きさ I 、電流の流れる方向と長さを表す微小ベクトル $d\mathbf{s}$) がベクトル \mathbf{r} 離れた点に作る微小磁場は $d\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi r^2} I d\mathbf{s} \times \frac{\mathbf{r}}{r}$ で与えられる(ビオ・サバルの法則)。真空の透磁率を μ_0 とする。コイルの中心に生じる磁束密度 $\mathbf{B} = (B_x, B_y, B_z)$ の z 成分 B_z を求めよ。

【20点】

3 真空の3次元 xyz 空間を考える。時間に依存しない一様な磁場を z 軸方向に印加する。磁場の磁束密度は $\mathbf{B}=(0,0,B)$ で与えられる。真空の誘電率を ϵ_0 、真空の透磁率を μ_0 とする。

【35点】

(1) 電荷 q ($q>0$) をもつ質量 m の粒子を時刻 $t=0$ に原点から x 軸方向に初速 v_0 ($v_0>0$) で打ち出す。時刻 t ($t>0$) における粒子の位置 (x,y,z) を求めよ。

さらに、時間に依存しない一様な電場 $\mathbf{E}=(E,0,0)$ を x 軸方向に印加する。

(2) 電荷 q ($q>0$) をもつ質量 m の粒子を時刻 $t=0$ に原点から x 軸方向に初速 v_0 ($v_0>0$) で打ち出す。時刻 t ($t>0$) における粒子の位置 (x,y,z) を求めよ。